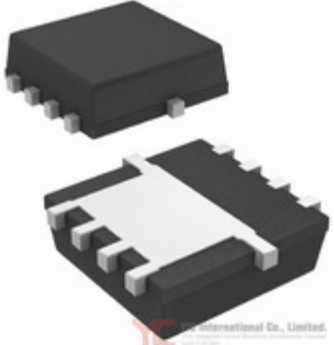


	<h2 style="color: #C00000;">SIS410DN-T1-GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIS410DN-T1-GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 35A PPAK 1212-8
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIS410DN-T1-GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 17996 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIS410DN-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 35A PPAK 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	17996 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.8 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

SIS410DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS410DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS410DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIS410DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIS412DN-T1-E3</b> VISHAY SIS412DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SIS4101PT1G</b> SIS SIS4101PT1G SIS</p>	 <p><b>SIS410DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SIS412DN</b> V SIS412DN V</p>
 <p><b>SIS407DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 25A 1212-8 PPAK</p>	 <p><b>SIS410DN</b> VB SIS410DN VB</p>	 <p><b>SIS412DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A 1212-8 PPAK</p>	 <p><b>SIS412DN-T1-GE3 QFN8</b> VISHAY SIS412DN-T1-GE3 QFN8 VISHAY</p>

### SIS410DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SIS410DN-T1-GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SIS410DN-T1-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SIS410DN-T1-GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SIS410DN-T1-GE3</a>
<a href="#">SIS410DN-T1-GE3 Electronic</a>	<a href="#">SIS410DN-T1-GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SIS410DN-T1-GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SIS410DN-T1-GE3-Bild</a>	<a href="#">SIS410DN-T1-GE3 Teil</a>	<a href="#">SIS410DN-T1-GE3 Inventar</a>
<a href="#">SIS410DN-T1-GE3 Preis</a>	<a href="#">SIS410DN-T1-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SIS410DN-T1-GE3 Bild</a>	<a href="#">SIS410DN-T1-GE3 Aktie</a>	<a href="#">SIS410DN-T1-GE3 RFQ</a>	<a href="#">SIS410DN-T1-GE3 Online bestellen</a>
<a href="#">SIS410DN-T1-GE3 Neu</a>	<a href="#">SIS410DN-T1-GE3 Original</a>	<a href="#">SIS410DN-T1-GE3 garantiert</a>			

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited